

Савчук Александр Александрович

**Разработка технологии выращивания слоев гетероструктуры на основе нитрида
галлия для лазерных диодов в устройствах освещения**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Специальность 2.2.3 – «Технология и оборудование для производства материалов и
приборов электронной техники»

Работа выполнена на кафедре полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС»

Научный руководитель: д.т.н., профессор, ведущий эксперт научного проекта НИТУ «МИСиС» Мурашев Виктор Николаевич.

Экспертная комиссия:

1. Ховайло Владимир Васильевич – д.ф.-м.н., профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» – председатель комиссии;
2. Лагов Петр Борисович - д.т.н., профессор, профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС»;
3. Мухин Сергей Иванович - д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической физики и квантовых технологий НИТУ «МИСиС»;
4. Якимов Евгений Борисович - д.ф.-м.н., заведующий лабораторией локальной диагностики полупроводниковых материалов ФГБУН Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН;
5. Пархоменко Юрий Николаевич - д.ф.-м.н., научный руководитель АО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»

Ведущее предприятие:

ФГБУН Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, г. Москва.

Защита диссертации состоится «30» ноября 2022 года по адресу 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 6, стр. 2.